

2SD838

超高耐压水平出力,
スイッチング用



2017

Triple Diffused Type Silicon Transistor

For Very High Voltage Switching Use

★Designed for a horizontal output stage of line operated solid state TV with big size CRT.

★Also for general high voltage use as regulator or switching use.

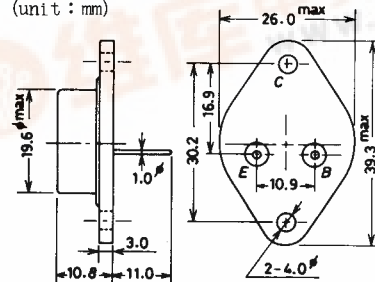
⊖ 579

用途 ・ラインオペレート方式の大口径トランジスタテレビ水平偏向出力段用に最適である。
・超高耐压水平出力, スイッチング用 および 高電圧印加測定器の定電圧電源出力用に最適である。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	2500 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	900 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	6 V
コレクタ電流	I_C	3 A
ピークコレクタ電流	i_{cp}	6 A
コレクタ損失	P_C $T_C=25^\circ\text{C}$	50 W
接合部温度	T_j	150 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-40~+150 $^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	unit
コレクタレキ断電流	$I_{CBO(1)}$ $V_{CB}=1000\text{V}, I_E=0$			50	μA
	$I_{CBO(2)}$ $V_{CB}=2500\text{V}, I_E=0$			1.0	mA
エミッタレキ断電流	I_{EB0} $V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			1.0	mA
コレクタレキ断電流	I_{CEO} $V_{CE}=900\text{V}, I_B=0$			10	mA
直流電流増幅率	h_{FE} $V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.5\text{A}$	3		15	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C=1.5\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			10	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ $I_C=1.5\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			1.3	V
下降時間	t_f $i_{cp}=1.5\text{A}$			1.0	μs

外形図 2017
(unit: mm)



EIAJ : TC-3, TB-3
JEDEC: TO-3

C: Collector
E: Emitter
B: Base